汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HS772

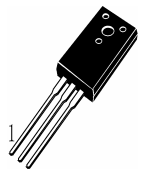
对应国外型号
2SB772

■ 主要用途

音频放大、开关功率放大

■ 外形尺寸及引脚排列

TO-126



1—发射极，E
2—集电极，C
3—基　极，B

■ 极限值（T_a=25℃）

T_{stg}——贮存温度…… -55~150℃

T_j——结温…… 150℃

P_C——集电极功率耗散（T_c=25℃）…… 10W

P_C——集电极功率耗散（T_A=25℃）……1W

V_{CBO}——集电极—基极电压……-40V

V_{CEO}——集电极—发射极电压……-30V

V_{EBO}——发射极—基极电压……-5V

I_C——集电极电流……-3A

I_B——基极电流……0.6A

■ 电参数（T_a=25℃）

参数符号	符　号　说　明	最小值	典型值	最大值	单 位	测　试　条　件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-1	μA	V_{CB}=-30V，I_E=0
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-1	μA	V_{EB}=-5V，I_C=0
h_{FE}	直流电流增益	60		400		V_{CE}=-2V，I_C=-1A
$V_{CE\ (sat)}$	集电极—发射极饱和压降		-0.3	-0.5	V	I_C=-2A，I_B=-0.2A
$V_{BE\ (sat)}$	基极—发射极饱和压降		-1.0	-2.0	V	I_C=-2A，I_B=-0.2A
C_{ob}	共基极输出电容		55		pF	V_{CB}=-10V，I_E=0，f=1MHz
f_T	特征频率		80		MHz	V_{CE}=-5V，I_E=-0.1A

■ 分档及其标志

R	Q	P	E
60—120	100—200	160—320	200—400

汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HS772

对应国外型号
2SB772

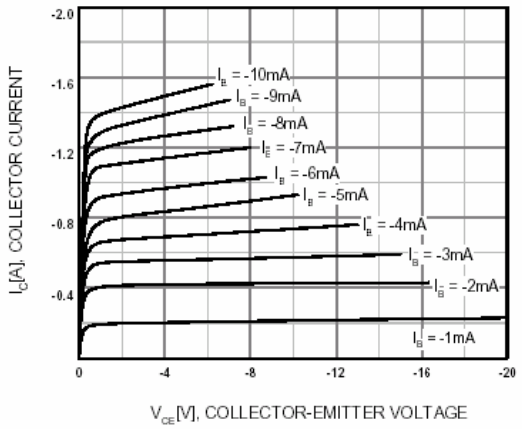


Figure 1. Static Characteristic

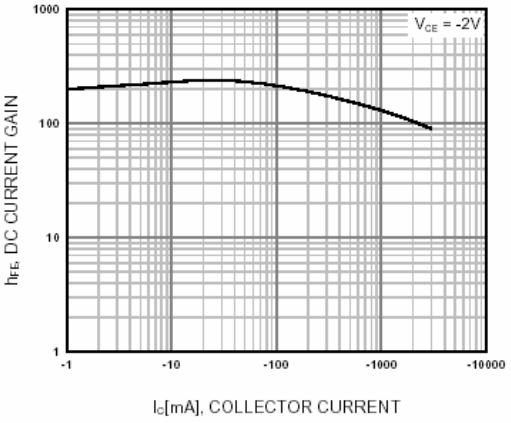


Figure 2. DC current Gain

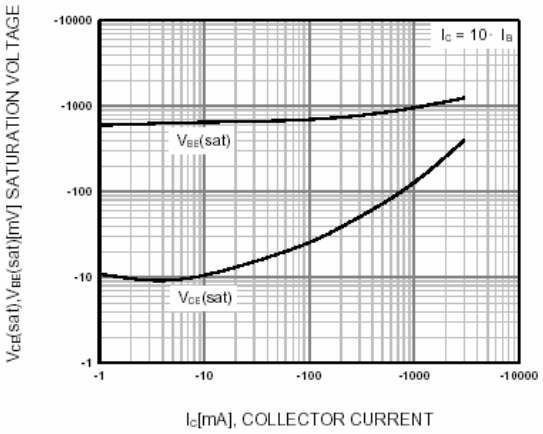


Figure 3. Base-Emitter Saturation Voltage Collector-Emitter Saturation Voltage

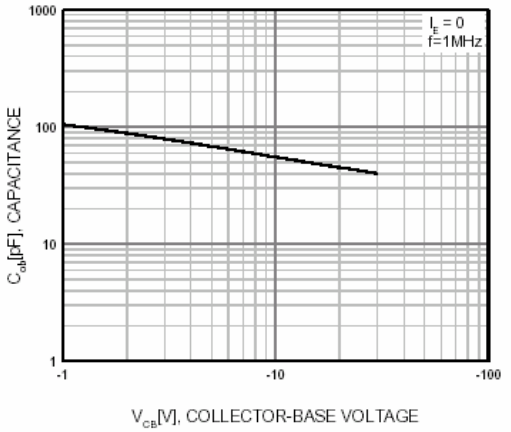


Figure 4. Collector Output Capacitance

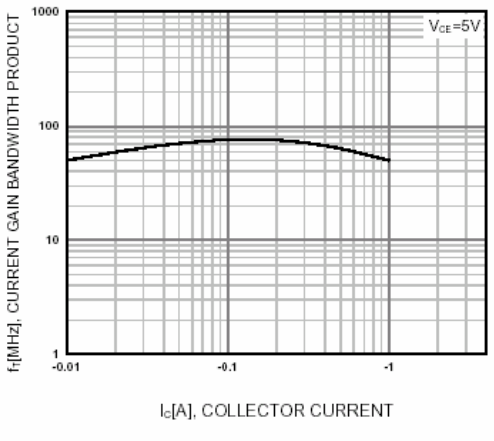


Figure 5. Current Gain Bandwidth Product

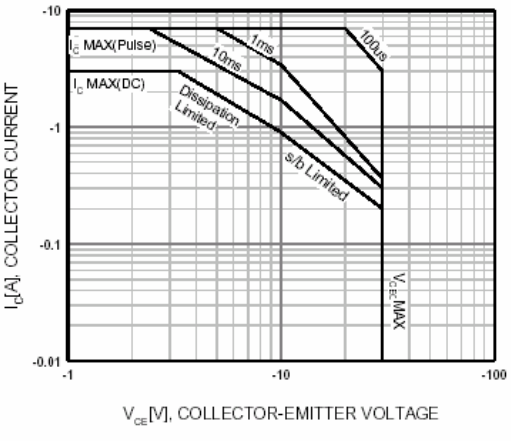


Figure 6. Safe Operating Area

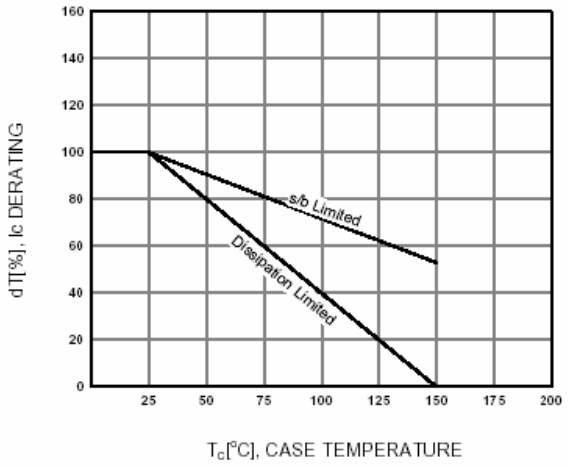


Figure 7. Derating Curve of Safe Operating Areas

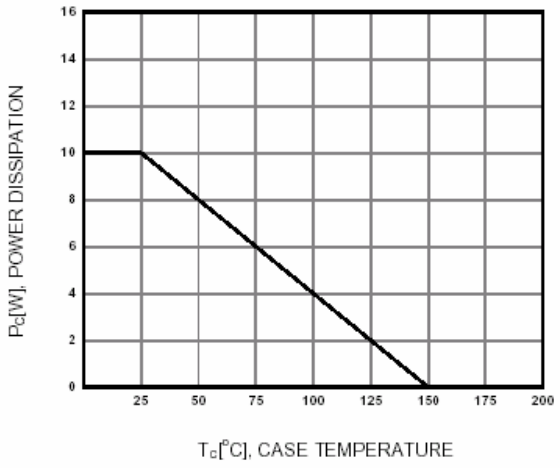


Figure 8. Power Derating